

用途：用于中功率放大。

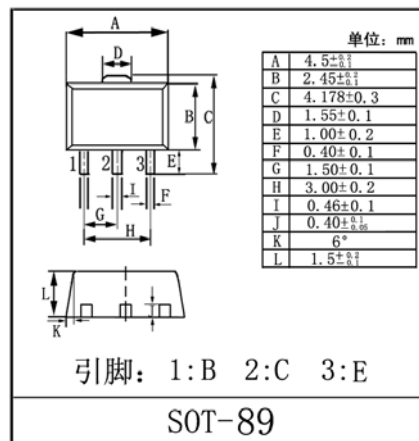
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点:饱和压降低, 与 2SD1767 (3DG1767) 互补。

Features: Low  $V_{CE(sat)}$ , complements the 2SD1767 (3DG1767).

极限参数/Absolute maximum ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
$V_{CBO}$	-80	V
$V_{CEO}$	-80	V
$V_{EBO}$	-5	V
$I_C$	-0.7	A
$P_C$	0.5	W
* $P_C$	2	W
$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$	-55~150	$^\circ\text{C}$



\*: mounted on 40×40×0.7mm ceramic board.

\*: 装于 40×40×0.7m 的陶瓷板上。

电性能参数/Electrical characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
$V_{CBO}$	$I_C=-50\mu\text{A}$	$I_E=0$	-80			V
$V_{CEO}$	$I_C=-2\text{mA}$	$I_B=0$	-80			V
$V_{EBO}$	$I_E=-50\mu\text{A}$	$I_C=0$	-5			V
$I_{CBO}$	$V_{CB}=-50\text{V}$	$I_E=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4\text{V}$	$I_C=0$			-0.5	$\mu\text{A}$
$h_{FE}$	$V_{CE}=-3\text{V}$	$I_C=-0.1\text{A}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$	$I_B=-50\text{mA}$		-0.2	-0.4	V
$f_T$	$V_{CE}=-10\text{V}$	$I_E=50\text{mA}$	$f=100\text{MHz}$	100		MHz
$C_{ob}$	$V_{CB}=-10\text{V}$	$I_E=0$	$f=1\text{MHz}$	14	20	pF

$h_{FE}$  分档、印章/ $h_{FE}$  Classifications、Marking:

$h_{FE}$ 分档/ $h_{FE}$ Classifications	P	Q	R
$h_{FE}$ 范围/ $h_{FE}$ Range	82~180	120~270	180~390
印章/Marking	HBDP *	HBDQ *	HBDR *



# 2SB1189 (3CG1189)

